

高知工科大学 総合研究所 ナノテク研シンポジウム 2014

日時： 2014 年 10 月 25 日（土）10:00～17:00
場所： 高知工科大学 C 棟 1F C102 （〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185）
主催： 高知工科大学 総合研究所 ナノテクノロジー研究センター
協賛： 応用物理学会中国・四国支部, 日本金属学会中四国支部
参加費： 無料, 申込： 参加申込は不要（直接会場にお越し下さい）

ープログラムー

開会の挨拶 高知工科大学 総合研究所 ナノテクノロジー研究センター 所長 八田章光

座長： 古田 守

10:10～10:30 「集束イオンビームによって作製した Ge 表面周期構造の微細化の検討」
松本亜里紗, 森田憲治（現: 日本 Casting）, 重松晃次（現: 九大院）, 新田紀子, 前田敏彦, 谷脇雅文（高知工科大学）

10:30～10:50 「大気圧プラズマジェット触媒表面処理による CNT の局所成長」
本郷知紀, 小路紘史, 呉 準席, 古田 寛, 八田章光（高知工科大学）

座長： 李 朝陽

10:50～11:10 「親水/疎水パターンニング基板における微粒子分散液滴の乾燥挙動」
中島大貴, 川原村敏幸（高知工科大学）

11:10～11:30 「ZnO Nanorods Fabricated by Chemical Bath Deposition」
Shengwen Hou, Chaoyang Li, Toshiyuki Kawaharamura（Kochi University of Technology）

11:30～13:00 休憩

座長： 眞田 克

13:00～14:00 特別講演 1 「ラマン分光法およびルミネッセンス法の先端半導体デバイス不良解析への応用」
杉江隆一（東レリサーチセンター）

14:00～14:10 休憩

座長： 川原村敏幸

14:10～14:40 特別講演 2 「低温成長 $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ の結晶構造とそのアニール温度依存性」
富永依里子, 角屋 豊（広島大学）

14:40～14:50 休憩

座長： 八田章光

14:50～15:10 「 $\alpha\text{-In}_2\text{O}_3$ 薄膜の電気特性」
北島雅士, 伊藤義人, 金子健太郎, 藤田静雄（京都大学）

15:10～15:30 「Improvement of Bias-temperature Stress Stability of InGaZnO Thin-film Transistor by Fluorine Passivation of Traps」
Jingxin Jiang, Tatsuya Toda, Dapeng Wang, Mamoru Furuta（Kochi University of Technology）

15:30～15:50 「フェノール樹脂担持パラジウム触媒の開発とその表面解析」
浅原時泰, 西脇永敏（高知工科大学）

15:50～16:10 「High Performance and Stability of MESFETs with a-In-Ga-Zn-O Channel Grown by Atmospheric Pressure Solution-processed Mist CVD」
Giang T. Dang（University of Canterbury）, Toshiyuki Kawaharamura, Mamoru Furuta,（Kochi University of Technology）, Martin W. Allen（University of Canterbury）

閉会の挨拶 高知工科大学 研究本部長 木村 良

16:30～17:00 ナノテクノロジー研究センター 施設見学（学外参加者対象）

（一般講演は発表時間 10 分、討論時間 10 分、特別講演は討論時間を含む）

昼食について： 食堂が 11:30～13:30 の間で開店、売店は閉店、コンビニは車で 10 分です。

連絡・問合せ先： 高知工科大学 総合研究所 新田紀子

Tel: 0887-57-2775 (ex. 3682), e-mail: nitta.noriko@kochi-tech.ac.jp